

	<h2 style="color: #D9534F;">SISC06DN-T1-GE3</h2>
	Hersteller-Teilenummer: SISC06DN-T1-GE3
	Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V
	Datenblätter:  SISC06DN-T1-GE3.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	



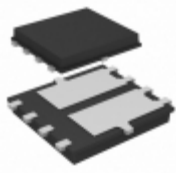

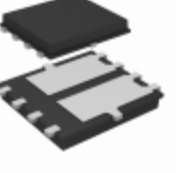



Spezifikationen

Teilenummer	SISC06DN-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.1V @ 250µA
Vgs (Max)	+20V, -16V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Serie	TrenchFET® Gen IV
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.7 mOhm @ 15A, 10V
Verlustleistung (max)	3.7W (Ta), 46.3W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Andere Namen	SISC06DN-T1-GE3TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	32 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2455pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	58nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	Schottky Diode (Isolated)
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 27.6A (Ta), 40A (Tc) 3.7W (Ta), 46.3W
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	27.6A (Ta), 40A (Tc)

SISC06DN-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SISC06DN-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SISC06DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SISC06DN-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SISC050N10DX1SA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CHAN SAWED WAFER</p>	 <p>SISC097N24DX1SA1 International Rectifier (Infineon Technologies) TRANSISTOR P-CH BARE DIE</p>	 <p>SISB46DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 40V POWERPAK 1212-8</p>	 <p>SISC29N20DX1SA1 International Rectifier (Infineon Technologies) TRANSISTOR P-CH BARE DIE</p>
 <p>SISB46DN-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET ARRAY 2N-CH 40V 1212-8</p>	 <p>SISC185N06LX1SA1 International Rectifier (Infineon Technologies) TRANSISTOR P-CH BARE DIE</p>	 <p>SISC262SN06LX1SA1 International Rectifier (Infineon Technologies) TRANSISTOR P-CH BARE DIE</p>	 <p>SISC624P06X3MA1 Infineon Technologies SMALL SIGNAL+P-CH</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SISC06DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SISC06DN-T1-GE3 Datenblatt	SISC06DN-T1-GE3-Datenblätter	SISC06DN-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SISC06DN-T1-GE3
SISC06DN-T1-GE3 Electronic	SISC06DN-T1-GE3-Komponenten	SISC06DN-T1-GE3-Verteiler	SISC06DN-T1-GE3-Bild	SISC06DN-T1-GE3-Teil
SISC06DN-T1-GE3 Preis	SISC06DN-T1-GE3 Hersteller	SISC06DN-T1-GE3 Bild	SISC06DN-T1-GE3 Aktie	SISC06DN-T1-GE3 Inventar
SISC06DN-T1-GE3 Neu	SISC06DN-T1-GE3 Original	SISC06DN-T1-GE3 garantiert	SISC06DN-T1-GE3 RFQ	SISC06DN-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited